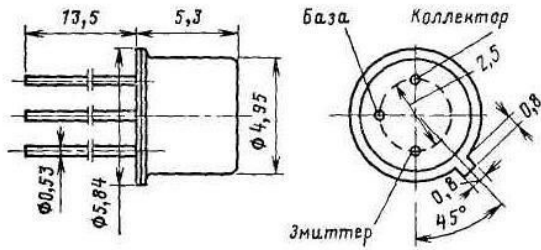


# 2Т326А, 2Т326Б, КТ326А, КТ326Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* высокочастотные и СВЧ усилительные. Предназначены для усиления высокочастотных и сверхвысокочастотных сигналов и для работы в схемах переключения.

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе. Масса транзистора не более 0,5 г.



## Электрические параметры

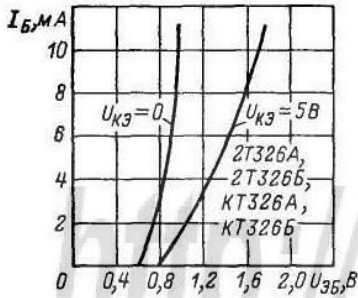
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при  $U_{КБ} = 2$  В,  $I_3 = 10$  мА

при  $T = 298$  К

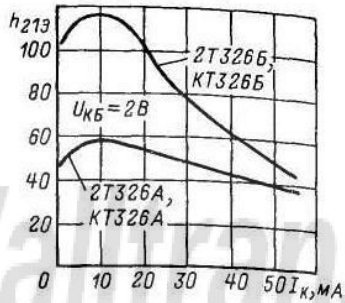
|                |        |
|----------------|--------|
| 2Т326А, КТ326А | 20–70  |
| 2Т326Б, КТ326Б | 45–160 |

при  $T = 213$  К

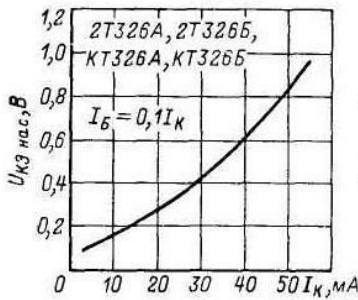
|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 2Т326А, 2Т326Б не менее | 0,3 значения при $T = 298$ К          |
| КТ326А                  | От 0,3 значения при $T = 298$ К до 70 |



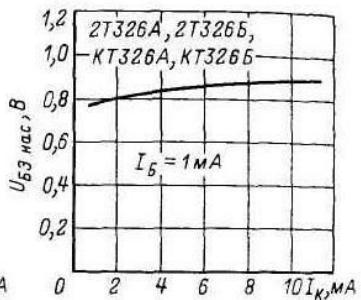
Зависимость тока базы от напряжения эмиттер-база



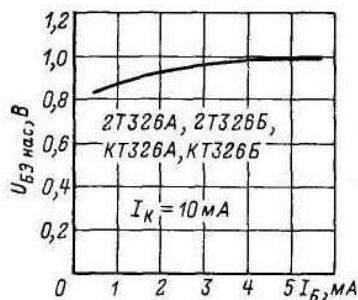
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



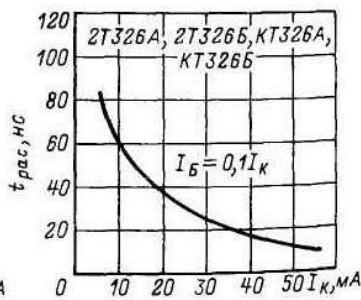
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока базы



Зависимость времени рассасывания от тока коллектора

|                          |  |
|--------------------------|--|
| КТ326Б                   | От 0,3 значения при $T = 298$ К до 160 |
| при $T = 398$ К          |  |
| 2Т326А, 2Т326Б, не более | 2 значения при $T = 298$ К             |
| КТ326А                   | От 10 до 2 значений при $T = 298$ К    |
| КТ326Б                   | От 2 до 2 значений при $T = 298$ К     |

Модуль коэффициента передачи тока при  $U_{КБ} = 5$  В,  $I_3 = 10$  мА,  $f = 100$  МГц не менее

|                |     |
|----------------|-----|
| 2Т326А         | 2,5 |
| 2Т326Б         | 4   |
| КТ326А, КТ326Б | 4   |

Обратный ток коллектора при  $U_{КБ} = 10$  В не более

|                 |         |
|-----------------|---------|
| при $T = 298$ К | 0,5 мкА |
| при $T = 398$ К | 10 мкА  |

Обратный ток эмиттера при  $U_{ЭБ} = 4$  В не более

|                 |         |
|-----------------|---------|
| при $T = 298$ К | 0,1 мкА |
| при $T = 398$ К | 10 мкА  |

Напряжение насыщения база-эмиттер при  $I_К = 10$  мА,  $I_Б = 1$  мА не более

|  |       |
|--|-------|
|  | 1,2 В |
|--|-------|

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при  $I_К = 10$  мА,  $I_Б = 1$  мА не более

|  |       |
|--|-------|
|  | 0,3 В |
|--|-------|

Постоянная времени цепи обратной связи при  $U_{КБ} = 5$  В,  $I_3 = 10$  мА,  $f = 5$  МГц не более

|  |        |
|--|--------|
|  | 450 пс |
|--|--------|

Емкость коллекторного перехода при  $U_{КБ} = 5$  В не более

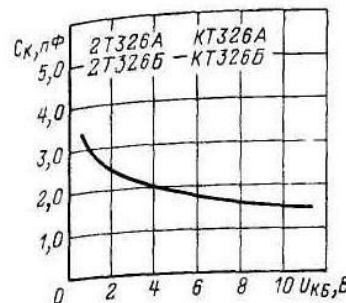
|  |      |
|--|------|
|  | 5 пФ |
|--|------|

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{ЭБ} = 0$  не более

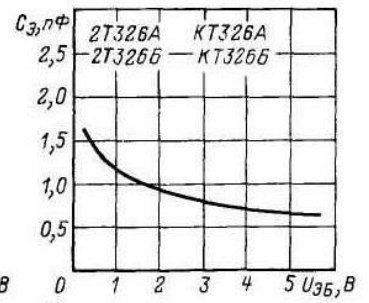
|  |      |
|--|------|
|  | 4 пФ |
|--|------|

## Предельные эксплуатационные данные

|  |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| Постоянное напряжение коллектор-база   | 20 В           |                 |
| Постоянное напряжение эмиттер-база   | 4 В            |                 |
| Постоянное напряжение коллектор-эмиттер  | 15 В           |                 |
| Суммарное постоянное и переменное напряжение коллектор-эмиттер в режиме усиления при $R_{ЭБ} \leq 100$ кОм | 20 В           |                 |
| Постоянный ток коллектора  | 50 мА          |                 |
| Постоянная рассеиваемая мощность коллектора  |                |                 |
| при $T = 213 - 298$ К  | 2Т326А, 2Т326Б | 250 мВт         |
| при $T = 398$ К  | 2Т326А, 2Т326Б | 83,3 мВт        |
| при $T = 213 - 303$ К  | КТ326А, КТ326Б | 200 мВт         |
| при $T = 398$ К  | КТ326А, КТ326Б | 41,7 мВт        |
| Температура перехода   |                |                 |
| 2Т326А, 2Т326Б   |                | 448 К           |
| КТ326А, КТ326Б   |                | 423 К           |
| Температура окружающей среды   |                | От 213 до 398 К |



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база



Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения эмиттер-база